



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Микроволновые системы»

ПРОГРАММА

II семинара-совещания

***«Актуальные вопросы разработки и применения
СВЧ компонентов и приборов на основе
технологии нитрида галлия»***

Ред. 01.11.2022

Москва, 2022 г.

II-й семинар-совещание будет проводиться **10 и 11 ноября 2022 г.** в помещении совмещенного конференц-зала «Москва-1»/«Москва-2» по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4 Г-Д (гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Дельта»), метро «Партизанская».

Ежедневный регламент работы семинара-совещания:

– регистрация участников	9:00 – 10:00
– утреннее заседание	10:30 – 11:30
– кофе-брейк	11:30 – 12:00
– продолжение заседания	12:00 – 13:30
– обед «шведский стол»	13:30 – 14:30
– вечернее заседание	14:30 – 17:00

Участие в семинаре-совещании бесплатное.

Для бронирования гостиничных номеров в гостиничном комплексе «Измайлово» рекомендуем обращаться по тел. +7 (495) 737-71-23, e-mail: sale@izmailovo.ru. При бронировании для получения скидки участникам совещания следует называть кодовое слово «НИТРИД».

Телефон для связи **участников** семинара с организаторами в период заезда, размещения и проведения мероприятия (9 – 11 ноября 2022 г.):
+7 (499) 644-21-03 (Секретариат)

Телефон для экстренной связи **докладчиков** в связи с возможными изменениями программы (болезнь, иные обстоятельства):
+7 (903) 721-87-60 (Миннебаев Вадим Минхатович)
+7 (903) 673-64-15 (Кищинский Андрей Александрович)

Программа

II семинара-совещания

«Актуальные вопросы разработки и применения СВЧ компонентов и приборов на основе технологии нитрида галлия»

Москва, АО «Микроволновые системы», 10-11 ноября 2022 г.

Время доклада	Авторы	Тема сообщения	Предприятие
10 ноября (четверг)			
1 заседание			
10-00... 10-15	А.А. Кишинский	Вступительное слово, представление участников семинара	АО «Микроволновые системы»
10-15 ... 10-30	А.А. Алексеев С.И. Петров	Разработка оборудования для эпитаксии GaN – переход от R&D к производственно-ориентированному уровню	АО «НТО»
10-30 ... 10-45	А.А. Арендаренко И.Г. Ермошин М.О. Никифоров Ю.Н. Свешников И.Н. Цыпленков	Гетероэпитаксиальные структуры нитридных соединений диаметром до 100 мм, изготовленные в отечественном промышленном реакторе планетарного типа	АО «Элма-Малахит»
10-45 ... 11-00	С. Д. Федотов В.В. Лундин Е.Е. Заварин А.В. Сахаров А.Ф. Цацульников Е.М. Соколов В.Н. Стаценко А.Г. Фефилов	Гетероструктуры нитрида галлия на сверхвысокоомном эпитаксиальном кремнии для СВЧ НЕМТ-транзисторов	АО «Эпиэл»/ НТЦ Микроэлектроники РАН / АО «НПП «Салют» (г. Нижний Новгород)
11-00 ... 11-15	А.С. Гусев_ С.А. Шостаченко А.Н. Клочков С.А. Номоев А.А. Горелов Ю.А. Тертышная А.Л. Кузнецов Н.И. Каргин	Получение и исследование III-нитридных НЕМТ гетероструктур с ультратонким барьером AlN	НИЯУ «МИФИ»
11-15 ... 11-30	Е.В. Луценко А.Г. Войнилович А.В. Нагорный М.С. Калинин А.А. Павлючик	Молекулярно-пучковая эпитаксия n++ GaN:Si для ультра низкоомных контактов транзисторов	Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси / МНИИРМ (г. Минск)
11-30 ... 12-00	Кофе – пауза		
2 заседание			
12-00 ... 12-15	С.А. Кукушкин (онлайн)	Эпитаксиальный нано-карбид кремния на кремнии — новый материал для микроэлектроники	ФГБУН «ИПМаш РАН»

Время доклада	Авторы	Тема сообщения	Предприятие
12-15 ... 12-30	О.Н. Минин Д.И. Засухин Е.А. Викторова	Формирование омического контакта к p-слою нитрида галлия с использованием предварительной ионной очистки	АО «НИИПП»
12-30 ... 12-45	М.Л. Занавескин И.А. Черных	Разработка фаундри процесса по технологии GaN-on-Si с топологическими нормами 0,15 мкм в НИЦ «Курчатовский институт»	НИЦ «Курчатовский институт»
12-45 ... 13-00	К.В. Дудинов	Выбор пути развития GaN технологий на отечественных предприятиях	АО «НПП «Исток» имени А.И. Шокина»
13-00 ... 13-15	В.М. Лукашин А.Б. Пашковский И.В. Пашковская	Оценка температурных свойств GaN полевого транзистора на Si подложке с эффективным теплоотводом	АО «НПП «Исток» имени А.И. Шокина»
13-15 ... 13-25	В.А. Беляков И.В. Макарец А.Г. Фефелов	Разработка GaN HEMT транзистора на основе гетероструктуры AlGaIn/GaN для работы в миллиметровом диапазоне длин волн	АО «НПП «Салют» (г. Нижний новгород)
13-30 ... 14-30	Обед		
3 заседание			
14-30 ... 14-45	М.В. Съедин	Потребности в GaN-микросхем для базовых усилительных модулей V-/Ka-/K-/Ku-/X-/C-/LS-диапазонов. Опыт тестирования в V-диапазоне	ООО «Элиарс»
14-45 ... 15-00	В.Л. Аронов А.А. Евстигнеев Д.М. Мосейкин А.М. Смирнов	Импульсный СВЧ транзистор 150 - 200 Вт X-диапазона	ООО «НПП «Радар-прибор»/ АО «НПП «Пульсар»
15-00 ... 15-15	И.В. Шуков Б.В. Емельянов Д.А. Евстигнеев А.М. Смирнов	Мощные СВЧ транзисторные сборки АО "НПП "Пульсар" на базе GaN кристаллов АО "Светлана-Рост"	АО «НПП «Пульсар»
15-15 ... 15-40	Д.М. Красовицкий А.Г. Филаретов В.П. Чалый	Нитридная СВЧ электроника в России - барьеры на переходе от технологии к бизнесу	АО «Светлана-Рост»
15-40 ... 15-55	Д.А. Кижя В.О. Хмелев	Доступная альтернатива WIN Semiconductor от китайской фабрики HiWafer	АО «Эпсилон»
15-55... 16-15	А.А. Кищинский	Дорожная карта" АО "Микроволновые системы по созданию и применению GaN транзисторов и МИС собственной разработки	АО «Микроволновые системы»
16-15... 17-00	Обсуждение тематики и вопросов, возникших в ходе дискуссий, выступления участников, свободная дискуссия.		

Время доклада	Авторы	Тема сообщения	Предприятие
11 ноября (пятница)			
4 заседание			
10-00... 10-15	В.В. Жуков А.М. Куканов Ф.Г. Искандеров А.М. Нечаев А.В. Сокол В.И. Ухандеев	Унифицированные усилители мощности для системы связи с OFDM сигналом для двух частотных диапазонов Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц	АО «НТЦ «ЭЛИНС»
10-15 ... 10-30	А.С. Андреев А.В. Радченко	Усилитель мощности для тропосферно-релейной связи диапазона 4,5-5,0 ГГц	АО «Микроволновые системы»
10-30 ... 10-45	Б.В. Калинин	Исследование линейных свойств усилителя мощности С-диапазона частот	ООО «Микровейв АйСи»
10-45 ... 11-00	А.В. Радченко С.В. Гармаш Т.А. Маркелова В.Н. Смирнов	Серия двухканальных сверхширокополосных усилителей мощности на основе GaN транзисторов и МИС	АО «Микроволновые системы»
11-00 ... 11-15	П.Л. Куршев	Гибридная интегральная микросхема импульсного усилителя мощности L-диапазона частот на основе GaN-транзисторов	АО «НИИЭТ»
11-15 ... 11-30	А.В. Бутерин А.В. Иванов А.С. Щербаков	Малогабаритный импульсный усилитель X-диапазона с выходной мощностью 150 Вт	АО «Микроволновые системы»
11-30 ... 12-00	Кофе – пауза		
5 заседание			
12-00 ... 12-15	С.В. Гармаш В.И. Протасов Д.А. Прытков В.В. Рябиков	Исследование вносимых амплитудных и фазовых флуктуаций импульсных СВЧ усилителей мощности на GaAs и GaN транзисторах	АО «Микроволновые системы»/АО «НИИП им. В.В. Тихомирова»
12-15 ... 12-30	В.Е. Акинин О.В. Борисов К.А. Иванов Ал.В. Редька	СВЧ усилитель X диапазона на GaN HEMT с выходной мощностью 360 Вт и воздушным охлаждением	АО «НПП «Пульсар»
12-30 ... 12-40	А.В. Анисимова П.Э. Осипов	Усилитель мощности 450 Вт миллиметрового диапазона на основе МИС GaN	ООО «Резонанс»
12-40 ... 12-50	Д.В. Перевертайло П.Э. Осипов	Освоение технологии производства усилителей мощности миллиметрового диапазона на основе МИС GaN	ООО «Резонанс»
12-50 ... 13-05	А.А. Евстигнеев Е.В. Курашов С.А. Поляков Т.В. Щерба	Разработка твердотельного СВЧ усилителя X-диапазона с импульсной выходной мощностью 5кВт для использования в составе РЛС	ООО «НПП «Радар-прибор»

Время доклада	Авторы	Тема сообщения	Предприятие
13-05 ... 13-20	А.В. Царев	Суммирование единичных GaN СВЧ транзисторов в составе мощного усилительного каскада с использованием симметричных цепей	АО «НИИМЭ»
13-20 ... 13-35	А.С. Самсонов	Актуальные вопросы разработки и применения СВЧ компонентов и приборов на основе технологии нитрида галлия	ФБГУ «ВНИИР»
13-35 ... 14-30	Обед		
6 заседание			
14-30 ... 14-45	П.В. Панасенко	Миниатюризация многокристалльных гетероинтегрированных СВЧ модулей	АО «НИИМЭ»
14-45 ... 15-00	С.М. Никулин А.А. Терентьев А.И. Торгованов	Вопросы проектирования транзисторных усилительных модулей на основе нелинейных S-параметров	ООО «Микроволновые измерения» / НГТУ им. Р.Е. Алексеева
15-00 ... 15-15	Д.И. Сотсков	Радиационные эффекты в изделиях СВЧ электроники на основе нитрида галлия, предназначенных для построения систем связи и обнаружения	АО «ЭНПО «СПЭЛС»
15-15 ... 15-30	Е.М. Савченко А.Д. Першин А.А. Мартынов М.В. Селиванов	Разработка схем управления питанием для мощных нитрид-галлиевых СВЧ усилителей на основе отечественной и зарубежной ЭКБ	ООО «ИнноЦентр ВАО»
15-30 ... 15-45	Е.С. Балобанов С.В. Зозуля И.Н. Данилов В.Е. Куликов О.И. Ширшиков Р.А. Яремчук	Перспективы использования отечественной электронной компонентной базы на основе нитрида галлия в разработке бортовых передающих устройств	Филиал ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им. Ю.Е. Седакова
15-45... 17-00	Заккрытие семинара-совещания, обсуждение тематики и вопросов, возникших в ходе дискуссий, выступления участников, свободная дискуссия.		

Материалы семинара-совещания в печати не публикуются.

Презентации выступлений будут направлены участникам **с разрешения авторов докладов** по электронной почте до 30.11.2022 г.